



陈中伟 编著

物理学教程第三卷

电磁学

上海交通大学出版社

电 磁 学

物理学教程 第三卷

陈中伟 编著

上海交通大学出版社

(沪)新登字 205 号

内 容 提 要

《物理学教程》是上海交通大学普通物理教研室编写的一套革新教材。全书分为力学、热学、电磁学、光学和量子物理基础四卷。

电磁学为本教材第三卷,内容包括真空中的静电场、电介质中的静电场、稳恒电流和磁场、磁介质中的磁场、随时间变化的电磁场等五章。

本书可作为对物理课程有较高要求的(非物理专业)理工科大学的物理学教学用书,也可作为一般高等院校的教学参考书,并可供中学物理教师参考。

责任编辑:冯 颖 戴柏诚

封面设计:雨 风

电 磁 学

物理学教程第三卷

出版:上海交通大学出版社

(上海市华山路 1954 号 邮政编码:200030)

发行:新华书店上海发行所

印刷:常熟市印刷二厂

开本:850×1168(毫米)1/32

印张:9.75 字数:251000

版次:1994年4月 第1版

印次:1994年5月 第1次

印数:1—3400

科目:317-272

ISBN 7-313-01317-5/O·44

定 价:8.30元

目 录

第一章 真空中的静电场	1
§ 1.1 静电场的高斯定理	1
§ 1.2 静电场的环流定律 电势	16
§ 1.3 场强与电势间的关系	21
§ 1.4 静电相互作用	32
选读材料 1. 静电场方程的微分形式	37
选读材料 2. 拉普拉斯方程和泊松方程	40
选读材料 3. 电像法	41
选读材料 4. 补充例题	43
小结.....	47
思考题.....	50
习题.....	54
第二章 电介质中的静电场	62
§ 2.1 电介质的极化	62
§ 2.2 电介质中静电场的基本规律	73
§ 2.3 电场的能量	81
* § 2.4 补充例题	89
选读材料 5. 电介质中静电场方程的微分形式	93
选读材料 6. 液体的介电常数	94
选读材料 7. 带电的具有旋转椭球表面的导体	95
小结.....	99
思考题.....	100
习题.....	102
第三章 稳恒电流和磁场	108
§ 3.1 均匀电路	108

§ 3.2	非均匀电路	114
§ 3.3	毕奥-萨伐尔定律	118
§ 3.4	圆电流的磁场	122
§ 3.5	磁场的高斯定理与安培环路定律	128
§ 3.6	洛伦兹力和安培力	137
* § 3.7	有关洛伦兹力的讨论	148
§ 3.8	电磁场的相对性	155
选读材料 8. 匀速运动点电荷的电磁场 ——相对论理论		159
选读材料 9. 低速运动的点电荷之间的电磁作用		164
选读材料 10. 静磁场方程的微分形式		165
选读材料 11. 正交电磁场中带电粒子的圆滚线运动		166
【附录】相对论中电场磁场变换式的证明		170
小结		171
思考题		174
习题		176
第四章 磁介质中的磁场		191
§ 4.1	磁介质的磁化	191
§ 4.2	磁介质中静磁场的基本规律	195
§ 4.3	抗磁性、顺磁性和铁磁性	205
选读材料 12. 介质中静磁场方程的微分形式		219
选读材料 13. μ 作为变量处理的磁路		220
小结		221
思考题		223
习题		224
第五章 随时间变化的电磁场		228
§ 5.1	电磁感应定律	228
§ 5.2	自感应和互感应	244
§ 5.3	磁场的能量	252
§ 5.4	位移电流 全电流定律	259

§ 5.5 麦克斯韦方程	269
§ 5.6 平面电磁波	274
小结	282
思考题	285
习题	289
习题答案	300

第一章 真空中的静电场

在这一卷中，我们将研究存在于电荷之间的电磁相互作用的理论。以前我们已经有了这方面的认识和初步的理论，认识到作用在一个电荷上的力可以分成两部分。其中第一部分力与该电荷的运动速度无关，仅仅与该瞬时电荷所处的位置有关，称电力。电荷所受的电力取决于该点的电场强度 E ， $F_e = qE$ 。第二部分力不仅取决于电荷所处的位置，并且还与电荷运动的速度 v 密切相关，这部分力称为磁力，磁力由该点的磁感应强度 B 和电荷运动的速度 v 所决定， $F_m = qv \times B$ 。于是空间每一点分别需用两个矢量——电场强度 E 和磁感应强度 B 来描述，作用于电荷 q 的总电磁力可写成

$$F = q(E + v \times B), \quad (1-1)$$

上式中 F 称为洛伦兹力。洛伦兹力反映了电荷（不论是静止的还是运动的）之间的相互作用，是通过电磁场来进行的。电磁相互作用的另一方面还需要说明电磁场又是怎样激发起来的，要研究电磁场遵从的规律。

静止电荷之间只有电相互作用，静止电荷只激发电场，且电场不受时间而变化，称为静电场。本章首先研究静止电荷在真空中产生的电场，研究静电场有那些特点以及规律。

§ 1.1 静电场的高斯定理

一、点电荷电场的场强

设真空中的电场由点电荷 Q 所产生，则其周围电场中 P 点的场强 E 可表示为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, \quad (1-2)$$

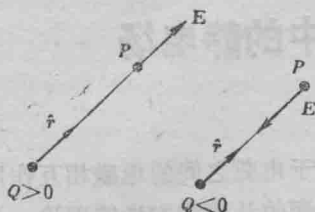


图 1-1

式中 r 是由电荷 Q 到 P 点之间的距离, $\hat{r}$ 为从点电荷 Q 指向 P 点的矢径 r 方向的单位矢量。场强的量值与距离 r 平方成反比。当 Q 为正电荷时, 场强方向背离 Q ; 当 Q 为负电荷时, 场强方向指向 Q , 如图 1-1 所示。

(1-2)式的证明:

根据静电现象的基本实验定律—库仑定律可知, 作用在 P 点处所假想引入的点电荷 q 的静电力为

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \hat{r}. \quad (1-3)$$

静电库仑力的量值与 Q 、 q 分别成正比, 与它们之间的距离 r 平方成反比, 且 Q 与 q 同号时为斥力, 异号时为引力, 如图 1-2 所示。式

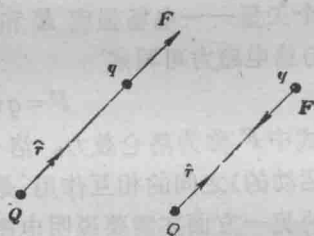


图 1-2

中 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 为国际单位制中引入的比例常量, 实验测定 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ Cr}^2/\text{Nm}^2$, ϵ_0 称为真空的介电常数。

P 点的场强 E 应等于单位正电荷在该点处所受的电场力, 即

$$E = \frac{F}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r},$$

上式即点电荷在真空中的场强公式(1-2)。

二、电场的叠加原理

如图 1-3 所示, 将试验电荷 q 放在点电荷 $Q_1, Q_2 \dots Q_n$ 所产生的电场中 P 点时, 实验表明 q 所受的力 F 等于各个点电荷各自单独产生的电场 $E_1, E_2, \dots E_n$ 对 q 作用力的矢量和。即

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}_1 + q\mathbf{E}_2 + \cdots + q\mathbf{E}_n$$

于是,由 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 所决定的总场强 $\mathbf{E}$,它等于各个点电荷在 P 点单独产生的场强的矢量和。这一实验规律称为电场场强的叠加原理。它可用数学式表示为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \cdots + \mathbf{E}_n$$

(1-4)

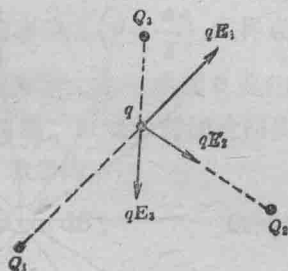
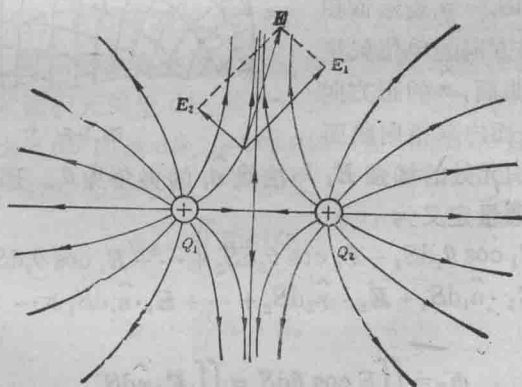


图 1-3

图 1-4 表示由两个电量相等的点电荷($Q_1 = Q_2 > 0$)的电场叠加得到的电场分布,以及由两个电量等值异号的点电荷($Q_1 = -Q_2 > 0$)的电场叠加得到的电场分布,图中画出了 P 点场强叠加的情况。

由于任意的电荷分布都可以处理为一系列(其数目或是有限个,或是多穷多个)点电荷的集合,所以有了点电荷场强公式(1-2)和场强叠加原理(1-4)式,从原理上讲,已经解决了从已知的电荷分布求其所产生的电场场强的问题,使它转化为一个数学计算的问题。



$$Q_1 = Q_2 > 0$$

(a)

图 1-4

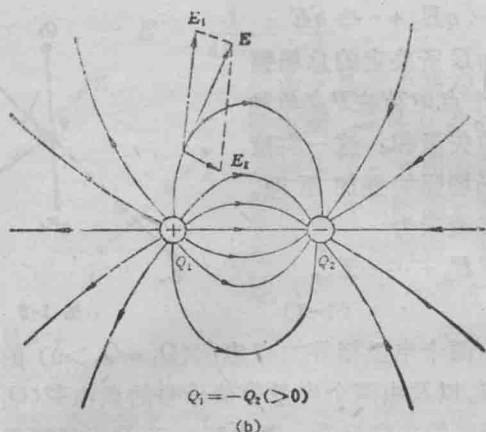


图 1-4

三、 E 通量

设想在电场中有一曲面 S , 如图 1-5 所示, 我们把它细分为无数个微小的面积元 $dS_1, dS_2, \dots, dS_i, \dots$. $\hat{n}_i$ 表示面积元 dS_i 法线方向的单位矢量 (对于闭合曲面, $\hat{n}$ 的正方向规定为由曲面内部指向曲面外部)。面积元处的场强 E_i 与法线 $\hat{n}_i$ 的夹角为 θ_i 。那么, 通过曲面 S 的 E 通量定义为

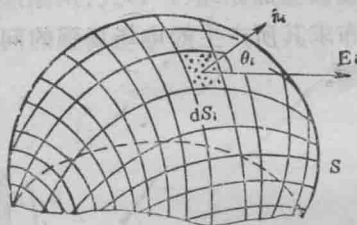


图 1-5

$$\begin{aligned}\Phi_E &= E_1 \cos \theta_1 dS_1 + E_2 \cos \theta_2 dS_2 + \dots + E_i \cos \theta_i dS_i + \dots \\ &= \mathbf{E}_1 \cdot \hat{n}_1 dS_1 + \mathbf{E}_2 \cdot \hat{n}_2 dS_2 + \dots + \mathbf{E}_i \cdot \hat{n}_i dS_i + \dots\end{aligned}$$

或

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E} \cos \theta dS = \iint_S \mathbf{E} \cdot \hat{n} dS, \quad (1-5)$$

式中累加或积分遍及整个曲面 S , 称为面积分。注意到因子 $\cos \theta$ 可为正值 ($0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$), 也可为负值 ($\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$), 因此通过面积元

dS 的 $\mathbf{E}$ 通量可为正值, 也可为负值, 或者为零 ($\theta = \frac{\pi}{2}$)。同样通过 S 面的总的 $\mathbf{E}$ 通量也可能为正、为负或为零。如果曲面 S 是闭合的, 在(1-5)式中的面积分符号上加一圆圈, 以表示对闭合曲面 S 求面积分。通过闭合曲面 S 的 $\mathbf{E}$ 通量表示为

$$\Phi_E = \oiint_S E \cos \theta dS = \oiint_S \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS. \quad (1-6)$$

$\mathbf{E}$ 通量是矢量场通量的一种。例如, 在流体流动的过程之中, 各点的流速 $\mathbf{v}$ 形成一流速场, 通过某一面积 S 的流速 $\mathbf{v}$ 的通量, 根据定义应是 $\Phi = \iint_S v \cos \theta dS = \iint_S \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS$, 它具有明显的物理意义: 单位时间内通过 S 面的流体的体积, 即体积流量。 $\mathbf{E}$ 通量没有更明显的意义。但它可以形象化地表示为穿过 S 面 $\mathbf{E}$ 线的数目。因为要使 $\mathbf{E}$ 线不但能表示电场中各点场强 $\mathbf{E}$ 的方向, 并且还能表示各点场强的大小, 必须规定 $\mathbf{E}$ 线的作法: 在电场中任一点, 与 $\mathbf{E}$ 正交的面积元上每单位面积通过的 $\mathbf{E}$ 线数目等于该点 $\mathbf{E}$ 的量值。因而穿过与 $\mathbf{E}$ 正交的面积元 dS 的 $\mathbf{E}$ 线数目等于 $E dS$ ($\mathbf{E}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 同方向), 它等于通过 dS 面积元的 $\mathbf{E}$ 通量。所以, 通过 S 面的 $\mathbf{E}$ 通量, 可以形象化地说成穿过 S 面的 $\mathbf{E}$ 线的数目。

如果引入面积元矢量 $d\mathbf{S}$, 其大小等于 dS , 其方向沿法线的正方向 $\hat{\mathbf{n}}$, 那么 $\hat{\mathbf{n}} dS$ 即是 $d\mathbf{S}$, $E \cos \theta dS = \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$, 则(1-5)式或(1-6)式可重写为

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}, \quad (1-7)$$

$$\Phi_E = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1-8)$$

四、高斯定理

现在我们已经具备了必要的知识来研究静电场的一个基本规律——高斯定理。真空中的高斯定理表述如下:

真空中,任何静电场通过任一闭合曲面的 $\mathbf{E}$ 通量,它等于这闭合曲面所包围的电荷电量的代数和的 ϵ_0 分之一倍。

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum Q_i}{\epsilon_0}, \quad (1-9)$$

(1-9)式是高斯定理的数学表示式。

高斯定理的证明

我们先从点电荷 Q 的静电场这一特例开始讨论。

(1) 设点电荷 Q 在闭合曲面之外。如图 1-6(a)所示,以点电荷 Q 为顶点作一微小锥面,它在闭合曲面上截出面积元 dS_1 和 dS_2 ,点电荷 Q 到这两个面积元的距离分别为 r_1 和 r_2 ,面积元正法线方向与场强的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 ,则通过该两面积元的 $\mathbf{E}$ 通量之和为

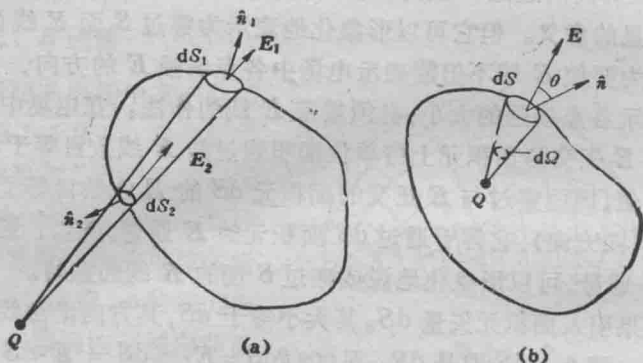


图 1-6

$$\begin{aligned} d\Phi_{E1} + d\Phi_{E2} &= E_1 \cos \theta_1 dS_1 + E_2 \cos \theta_2 dS_2 \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{dS_1 \cos \theta_1}{r_1^2} + \frac{dS_2 \cos \theta_2}{r_2^2} \right). \end{aligned}$$

注意到对于闭合曲面来说,面积元的正法线方向总是指向闭合曲面的外侧,所以 $\cos \theta_1$ 和 $\cos \theta_2$ 的正负号相异,但 $\frac{|dS_1 \cos \theta_1|}{r_1^2}$ 与 $\frac{|dS_2 \cos \theta_2|}{r_2^2}$ 数值相等,它等于该微小锥面所张的立体角 $d\Omega$ 。所以

$$d\Phi_{E1} + d\Phi_{E2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} (d\Omega - d\Omega) = 0。$$

对于整个曲面来说,可以看成无数对这样的面积元的集合,因此当闭合曲面不包围点电荷时,通过闭合面的 $\mathbf{E}$ 通量 Φ_E 为零。

(2) 设点电荷 Q 在闭合曲面的内部。如图 1-6(b) 所示,通过面积元的 $\mathbf{E}$ 通量为

$$d\Phi_E = E \cos \theta dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dS \cos \theta}{r^2}。$$

通过闭合曲面的 $\mathbf{E}$ 通量为

$$\begin{aligned} \Phi_E &= \oint_S E \cos \theta dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} (4\pi) = \frac{Q}{\epsilon_0}。 \end{aligned}$$

式中用到绕一顶点的总立体角等于 4π (因为半径 $R_0=1$ 的球面上,所有面积元 dS 的总和等于球面积 $4\pi R_0^2=4\pi$)。这一结论适用于所有形状的闭合曲面(参见思考题 1.7)。

根据电场的叠加原理,可把由点电荷电场得到的结论推广到

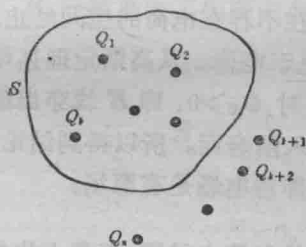


图 1-7

任意的带电系统的静电场。把带电系统看作一系列点电荷的集合,如图 1-7,把叠加原理(1-4)式

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i$$

代入通过闭合曲面电通量的表达式(1-8)得

$$\begin{aligned} \Phi_E &= \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i \right) \cdot d\mathbf{S} = \sum_{i=1}^n \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} \\ &= \oint_S \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S} + \dots + \oint_S \mathbf{E}_n \cdot d\mathbf{S} \\ &= \Phi_{E1} + \dots + \Phi_{En}, \end{aligned}$$

设这 n 个点电荷系统中, $Q_1, Q_2 \dots Q_n$ 位于闭合曲面 S 的内部;

$Q_{k+1}, Q_{k+2} \dots Q_n$ 位于闭合曲面 S 的外部。则由前面关于点电荷电场的结论

$$\Phi_{E_i} = \frac{Q_i}{\epsilon_0}, \quad (i = 1, 2 \dots k)$$

$$\Phi_{E_i} = 0, \quad (i = k+1, k+2 \dots n)$$

所以,

$$\Phi_E = \sum_{i=1}^n \Phi_{E_i} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^k Q_i,$$

式中 $\sum Q_i$ 为闭合曲面所包围电荷电量的代数和。这一表达式就是高斯定理的数学表示式(1-9)。

为了理解高斯定理的物理意义,我们设想所有电荷都分布在

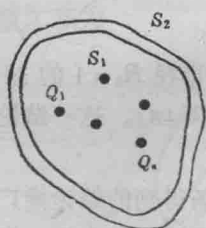


图 1-8

闭合曲面 S_1 的内部,在 S_1 的外部作一个包围 S_1 面的闭合曲面 S_2 ,如图 1-8 所示。根据高斯定理,通过 S_1 和 S_2 两闭合面的 E 通量应相等。从 E 线的观点来看,穿过 S_1 面和 S_2 面的 E 线的数目必须相等。它表明: E 线不可能由不存在电荷的空间发出,也不可能在不存在电荷的空间终止。即

E 线必须从电荷发出,或者必须终止于电荷。从高斯定理还可看出,闭合曲面包围的电荷 Q 为正电荷时, $\Phi_E > 0$, 即 E 线穿出闭合面; Q 为负电荷时, $\Phi_E < 0$, 即 E 线穿入闭合面。所以得到结论是, E 线从正电荷发出,终止于负电荷,即静电场是有源场。

五、关于均匀带电球面、无限长均匀带电柱面、无限大均匀带电平面的电场的讨论

1. 均匀带电球面的电场

设有半径为 R 的球面,其上均匀分布着电荷 Q ,如图 1-9 a 所示。现讨论其电场的特点,并进一步计算各点的场强。由于电荷在球面上呈均匀分布,因此任意一点的场强 E 必须沿着过该点的半径方向(设想场强沿如图虚线 E' 方向,则表示右半球面的电荷

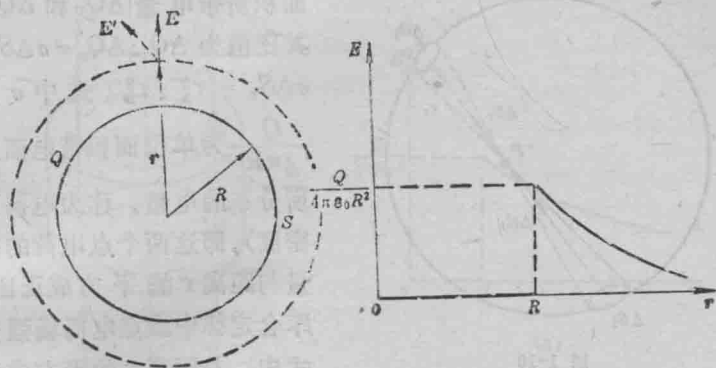


图 1-9

对场的贡献大于左半球面，这是不可能的)。并且 E 的量值只能是场点离开球心距离 r 的函数，与带电球面同心的任一球面上 E 的量值都相同。这样，若选用一个半径为 r 的同心球面为高斯定理中的闭合曲面（简称高斯面），通过该球面的 E 通量可表示为 $\Phi_E = 4\pi r^2 E$ 。另一方面，若 $r > R$ ，高斯面内包围的总电量等于 Q ，若 $r < R$ ，高斯面内不包围电荷。所以

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}, \quad (r > R), \quad (1-10a)$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}.$$

或

$$4\pi r^2 E = 0, \quad (r < R). \quad (1-10b)$$

$$E = 0.$$

场强随到球心的距离 r 变化关系如图 1-9b 所示。由此可见，均匀带电的球面对球外各点的作用，正像球面上所带的电荷全部集中于球心的点电荷一样。至于在均匀带电球面内任一点场强为零，则可由库仑定律或点电荷的场强公式来作出解释。参看图 1-10，球面上任一小面积 ΔS_1 对 P 点张一小锥形，从 P 点向相反方向伸展锥形在球面上截取对应的一小面积 ΔS_2 ，设 P 点到小面积 ΔS_1 和 ΔS_2 的距离分别是 r_1 和 r_2 ，则 $\Delta S_1 : \Delta S_2 = r_1^2 : r_2^2$ ；每一小

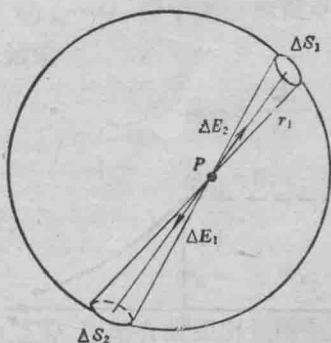


图 1-10

面积所带电量 ΔQ_1 和 ΔQ_2 , 其比值为 $\Delta Q_1 : \Delta Q_2 = \sigma \Delta S_1 : \sigma \Delta S_2 = r_1^2 : r_2^2$ (式中 $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$ 为单位面积带电面上所分布的电量, 称为电荷面密度), 即这两个点电荷的电量与距离 r 的平方成正比。库仑定律中或点电荷场强公式中, 与距离 r 的平方成反

比恰好被电量与 r 的平方成正比所补偿, 所以它们在 P 点产生的场强量值相等而方向相反, 它们的合场强相消为零。整个带电球面可看作无数对这样的点电荷的集合, 于是整个带电球面在其内部产生的场强为零。这是库仑定律中 r 的幂次数精确地等于 -2 的必然结果。

2. 无限长均匀带电圆柱面的电场

设有半径为 R 的无限长均匀带电圆柱面, 电荷面密度为 σ , 单位轴向长度上的电量 $\lambda = 2\pi R\sigma$, 在圆柱面上 L 长的一段带电量 $Q = 2\pi RL\sigma = L\lambda$ 。由于电荷分布对圆柱轴线呈轴对称性分布, 任何一点 P 的场强 E 的方向必定在过轴线的平面内且垂直于轴线, 如图 1-11a 所示; 场强 E 的量值只能与 P 点离开轴线的距离 r 有关。若过 P 点作一个半径为 r 的、与带电圆柱面同轴的圆柱面, 再作两个距离等于 L 且垂直圆柱轴线的平面, 形成一个闭合的圆柱表面。通过圆柱侧面的 E 通量等于 $2\pi rLE$ (因圆柱面上各点 E 的方向与圆柱面正交且量值相等), 通过两底面的 E 通量为零 (E 的方向与底面平行), 所以

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\text{圆柱面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{上底面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{下底面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_{\text{圆柱面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi rLE.\end{aligned}$$

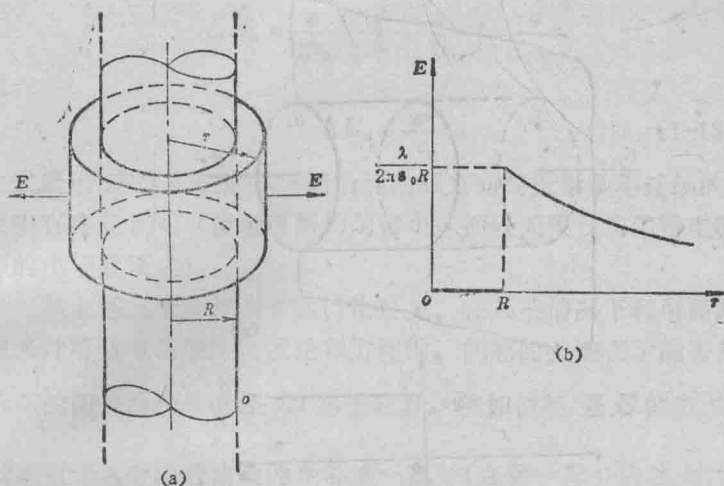


图 1-11

根据高斯定理, $\epsilon_0 \Phi_E$ 等于闭合圆柱面内包围的电荷总量。若 $r > R$, 闭合面内包围有电荷, 其电量为 $Q = 2\pi RL\sigma = L\lambda$, 则

$$2\pi rLE = \frac{2\pi RL\sigma}{\epsilon_0} = \frac{L\lambda}{\epsilon_0},$$

所以

$$E = \frac{R\sigma}{\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, (r > R). \quad (1-11a)$$

若 $r < R$, 闭合曲面内不存在电荷, $Q = 0$, 则

$$E = 0, (r < R). \quad (1-11b)$$

场强随场点离开圆柱面轴线距离的变化关系, 如图 1-11b 所示。

3. 无限大均匀带电平面的电场

设无限大均匀带电平面, 电荷面密度为 σ , 由于电荷均匀分布于延伸到无限远的整个平面上, 任意一点 P 的场强 E 的方向必定垂直于平面, 且场强 E 的量值只能与场点离开平面距离 d 有关 (读者试分析何故?)。如图 1-12 a, 我们作一个柱面, 其母线与带电平面正交, 再在带电平面两侧作两个平行平面, 它们与带电平面距离都等于 d , 形成一个闭合柱面。由于在两底面 S_1 和 S_2 上, E